YBaCuO 陶瓷的 XPS 研究*

冯锡淇 李承恩 殷之文 应继锋 刘建成

(中国科学院上海硅酸盐所)

13 1210

XPS(X光电子能谱)测量结果表明;YBaCuO陶瓷的Ba34 谱线由两种不同结金能的Ba34 谱线组成,它们的相对强度随烧结温度不同而有明显差异,其临界温度 *T*。也不同。它们可能对应于不同相的 YBaCuO 化合物,其相对含量因烧结条件而异。本文还研究了 Ar*离子轰击对 YBa,Cu,O_{7-*}超导陶瓷的影响,离子 轰击后, 呈单一的 Ba3d 谱线, Cu2p 谱线则还原为较低的价态,其效果与真空退火处理十分相似。

关键词:YBaCuO 陶瓷;X光电子能谱;烧结温度;离子轰击

XPS 可用来研究 YBaCuO 陶瓷系统的电子结构、组分和化学键性质等 问题。 这 对于 探索较好的高 7。超导陶瓷制备工艺是有意义的。而且,它也可以用来研究低能 离 子轰击 对 YBa₂Cu₃O₇₋。超导陶瓷的影响,这些知识不仅对于这类材料的表面分析技术本身是必需 的,而且对于用离子束技术进行 YBaCuO 陶瓷的表面处理和改性也是必不可少的。

本工作所用的 YBaCuO 陶瓷以固态反应法制备,烧结温度为 970℃。 X 射线衍射测试 表明,该材料主相为正交超导相 YBa₂Cu₃O_{7-x}, *T*。为 93 K。样品呈黑色,密度约 5.8~5.9 g/cm³。测试前,样品表面略加研磨,经丙酮仔细清洗,充分干燥后送入样 品室。 XPS 测 量是在 PHI-550 ESCA/Auger 能谱仪中完成。 X 射线激发源为单色的 MgKa 线辐射 (*hv* = 1253.6 eV)。以陶瓷表面层的微量沾污碳作结合能的能量定标。Ar⁺ 离子轰击是以该谱仪 中用于深度分布测量的典型的离子溅射参数完成的(E₁= 3.0 keV, 30 min, 6×6 mm² 轰击 面积)。

图 1 为 YBaCuO 陶瓷的 Ba 3d 谱线,其中(a)为临界温度 T_{s} = 93 K 左右样品中的 Ba 3d 线,样品烧结温度为970℃,而(b)为另一样品的相应谱线,而该样品在制备过程中烧结温度 偏高(1000℃),它在 77 K 以上不呈超导态。从图 1 看出,二种样品均含有二种不同结合 能的 Ba 3 d 谱线,按其结合能的高低分别记作 Ba 3 d_s ((Ba 3 d_{3/2}: 794.6 eV, Ba 3 d_{s/2}: 779.3 eV)和 Ba 3 d_s(Ba 3 d_{3/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_s (= H Ba H d_s) a d i d_s (= H Ba H d_s) a d i d_s (= H Ba H d_s) a d d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_s (= H Ba H d_s) d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_s (= H Ba H d_s) d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_s (= H Ba H d_s) d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_s (= H Ba H d_s) d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_s (= H Ba 3 d_s (= H Ba H d_s) d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_s (= H Ba H d_s) d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_{s/2}: 797.8 eV) a Ba 3 d_s (= H Ba H d_s) d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_{s/2}: 797.8 eV) a Ba 3 d_s (= H Ba H d_{s/2}: H d_{s/2} d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_{s/2}: H Ba 3 d_s (= H Ba H d_{s/2}: H d_{s/2} d_{s/2}: 797.8 eV, Ba 3 d_{s/2}: 782.4 eV)。处于低能一侧的 Ba 3 d_{s/2}: H Ba 3 d_{s/2}: H Ba 3 d_{s/2}: H d_{s/2}: H

* 1988 年 2 月 11 收到初稿, 4 月 22 日修回。 国家自然科学基金资助项目。



- 图 1 不同烧结温度制得的 YBaCuO 陶瓷的 Ba 3 d 谱线
- Fig. 1. Ba 3 d core lines of YBaCuO ceramics prepared under different sintering temperatures
- (a) Sintering temoerature 970°C, Critical temperature 93 K
- (b) Sintering temperature 1000°C, Critical temperature <77 K





- 图 200 YBa2Cu3O7-# 超导陶瓷 表面的 Ba 3 d 谱线
- Fig. 2. Ba 3 *d* line spectra from Y-Ba-Cu-O ceramics surface (a) Untreated
 - surface
 - (b) Ar⁺ ion bombardment surface
- 图 3 YBa,Cu₃O_{7-e} 超导陶瓷 表面的Cu 2 p 谱线 Fig. 3. Cu 2 p core line spectra from Y-Ba-Cu-O ceramics surface (a) Untreated surface. (b) Ar^{*} ion bombardment surface

Ba₃YCu₂O₂化合物有关。 从图 2 看出, 经 Ar⁺ 离子表击后, Ba 3 d_{*} 谱线消失, 表明上述 二种化合物的稳定性较差。总之, 从 Ba 3 d 谱线的测量结果看出, XPS 测量有助于确定较 好的 YBaCuO 超导陶瓷的烧结工艺。

图 3 为 YBa₂Cu₃O_{7-*} 超导陶瓷的 Cu2 p 谱线,注意 Cu 2 $p_{3/2}$ 和 Cu 2 $p_{1/2}$ 比一般 铜 化 合物中的 Cu2 p 谱线宽得多。按照 H. Ihara 等对类似的 SrLaCuO 超导陶瓷中相应 谱线的 解释,它们系由三种不同价态的铜离子 Cu⁺、Cu²⁺ 和 Cu³⁺ 组 成,其中 Cu 2 $p_{3/2}$ 的 结 合 能分别为 933.0,934.7 和 935.7 eV,相对强度比为 1:2:1^[2]。本文的结果与之极为接近。 图 3 中的 S 和 S' 峰归因于光电子的非弹性散射所引起的从 O 2 p 态到 Cu3 d 空穴态之间的 电子跃迁^[3]。经 Ar⁺ 离子轰击后 Cu2 p 谱线示于图 3(b),此时谱线明 显 变窄,而 Cu⁺ 态 升高,意味着 Cu²⁺ 和 Cu³⁺ 谱线强度大大降低,均转变为 Cu⁺ 态。同时 S 和 S' 峰消失,



Ar⁺ 离子轰击对 Y 3 d 谱线无明显影响,但谱线变得更清晰了,如图 4∞经离子轰击后, Ols 谱线呈二个主要的谱峰以及高能侧另一较小的谱峰,它们对应于 YBa₂Cu₃O₇₋, 陶 瓷中 几种不同的金属一氧离子键,见图 5。

从上述实验结果看出, XPS 测量有可能作为检验 YBaCuO 或其它高临界 温度 超导陶 瓷烧结工艺是否达到最佳效果的监测工具之一。如能分别合成 YBaCuO 系统中可能存在的 各主要化合物(單相)如: BaCuO。 Ba2YCu3O7-z、BaY2CuO6和 YBa2Cu3O7-z…等等。分别 完成其 XPS 标准谱线的测量, 并以X 射线衍射方法进行核对将能提供 YBaCuO 陶 瓷 系统 组分一结构一超导性能之间关系的有价值的信息。同时, XPS 深度分析所常用的 离子溅 射技术,提供了进行"低能离子轰击对 YBaCuO 陶瓷的影响"研究的方便手段。一般地,多 组分化合物中某些组分择优溅射,往往与样品组分中化学态的改变有联系。在许多氧化物材料中(特别是含有过渡金属离子的氧化物),常还原为较低的氧化态⁽⁴⁾。其效果与真空退 火处理十分相似。同样的现象我们在以 Ar⁺ 离子轰击类钙钛矿 型结构的铌酸锂晶体时已观 察到⁽⁵⁾。因此,在用离子束技术制备 YBa2Cu3O7-z超导薄膜(如:离子油入、离子束混合等)或进行薄膜的离子加工时,必须充分考虑这一影响。 云 。美好书宝酥油对合小种二

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Study on Y-Ba-Cu-O Ceramics by XPS

Feng Xiqi

ţ

Li Chengen Yin Zhiwen Ying Jifeng Liu Jiancheng

(Shanghai Institute of Ceramics, Academia Sinica)

Abstract

XPS measurements show that the Ba 3 d core line of Y-Ba-Cu-O ceramics consists of two lines with different bonding energies. The relative intensity of the two lines and critical temperature T_c change obviously when the sintering temperature is different. The two lines seem to be related to two compounds of YBaCuO. Their relative content is changed with sintering temperature. The effect of Ar⁺ ion bombardment on YBa₂Cu₃O_{7-x} ceramic superconductor has also been investigated. After bombardment, YBa₂Cu₃O_{7-x} ceramics have a single Ba 3 d core line and its Cu 2 p core line has been reduced to a lower valence. The effect of bombardment is very similar to that of the vaccum annealing.

Keywords: Y-Ba-Cu-O ceramics; XPS measurment; Ion bombardment; Sintering temperature.

A 1 1 1